



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种垂直沟道型三维半导体存储器件及其制备方法
专利类别:	国际专利
申请号:	PCT/CN2012/086511
申请日期:	2012-12-13
专利号:	9,437,609
第一发明人:	霍宗亮;刘明
实施情况:	授权
专利证书号:	9,437,609
其它备注:	微电子重点实验室

